

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

Nr 3597

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Kundförfrågningar

Semiconductor & Device Marketing Dept.A and Dept.B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

Medieförfrågningar

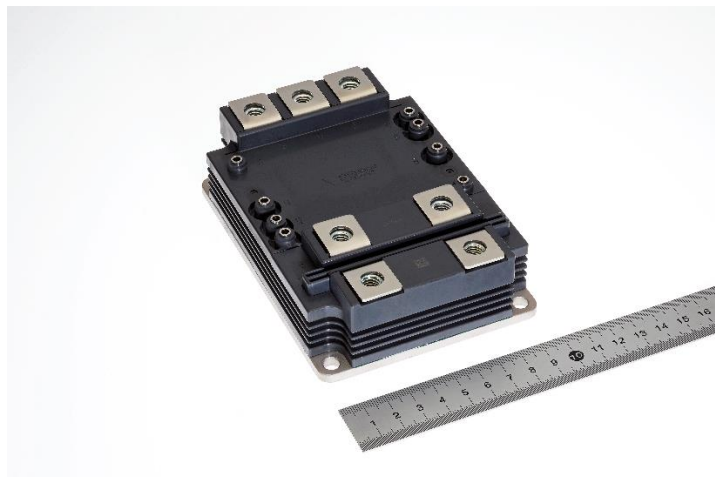
Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation

prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp

www.MitsubishiElectric.com/news/

Mitsubishi Electric levererar prover på SBD-inbäddad SiC-MOSFET-modul

För extra kraftfulla och effektiva växelriktarsystem som används inom järnväg, elkraftsystem och annat



3,3 kV SBD-inbäddad SiC-MOSFET-modul

TOKYO, 8 maj 2023 – [Mitsubishi Electric Corporation](https://www.mitsubishielectric.com) (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget börjar leverera prover på en ny SBD-inbäddad (Schottky Barrier Diode) SiC (Silicon Carbide) MOSFET-modul (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor), med Dual-Type 3,3 kV-spänningstålighet och 6,0 kVrms dielektrisk styrka, den 31 maj. Den nya modulen förväntas stödja överlägsen effekt, effektivitet och tillförlitlighet i växelriktarsystem för storindustriell utrustning som järnvägar och elektriska kraftsystem. Modulen visas på större mässor, inklusive Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2023 i Nürnberg, Tyskland den 9 till 11 maj.

Mitsubishi Electric har redan släppt fyra full-SiC-moduler och två Dual-Type LV100 3,3 kV-högspänningsmoduler. För att ytterligare bidra till hög uteffekt, effektivitet och tillförlitlighet i växelriktare för storindustriell utrustning börjar företaget snart tillhandahålla prov på den nya modulen, vilken minskar växlingsförlusten, som en SiC-MOSFET med inbyggd SBD och en optimerad paketstruktur.

Produktegenskaper

1) SBD-inbäddad SiC-MOSFET minskar effektförlusten och bidrar till växelriktarens uteffekt, effektivitet och tillförlitlighet

- SBD-inbäddad SiC-MOSFET och optimerad paketstruktur minskar växlingsförlusten med 91 % jämfört med företagets befintliga Si-effektmodul* och med 66 % jämfört med befintlig SiC-effektmodul**. Det minskar därmed effektförlusten i växelriktaren och bidrar till högre uteffekt och effektivitet.
- SBD-inbäddad SiC-MOSFET och optimerad strömkapacitet förbättrar växelriktarens tillförlitlighet.

2) Optimerad terminallayout anpassad till olika växelriktarkonfigurationer och kapaciteter

- Optimerad terminallayout möjliggör parallell anslutning och stöder olika växelriktarkonfigurationer och -kapaciteter beroende på antalet parallella anslutningar.
- Paketstrukturen, med DC- och AC-huvudterminaler i motsatta poler, bidrar till att förenkla kretskonstruktionen.

Huvudspecifikationer

Typ	FMF800DC-66BEW
Märkspänning	3,3 kV
Märkström	800 A
Isoleringsspänning	6,0 kVrms
Anslutning	2-i-1
Mått (B×D×H)	100×140×40 mm
Provlleverans	31 maj 2023

Den här produkten ligger under artikelnummer 2 (41)3 i den bifogade tabellen 1 i exportordern för handelskontroll.

Krafthalvledare används allt oftare för att effektivt omvandla elektrisk kraft för att minska koldioxidavtrycket i det globala samhället, särskilt i tung industri, där dessa enheter används i strömomvandlingsutrustning som växelriktare i järnvägssystem och för DC-överföring. Förväntningarna är särskilt höga för SiC-krafthalvledare på grund av deras förmåga att avsevärt minska effektförlusten. Dessutom används krafthalvledarmoduler i strömomvandlingsenheter för storindustriell utrustning. Efterfrågan ökar på högeffektiva krafthalvledare med hög effekt som bidrar till att förbättra effektiviteten vid strömomvandling.

Webbplats

<https://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/>

###

Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har mer än 100 års erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhället med teknik i enlighet med företagets motto, "Changes for the Better". Företaget noterade en omsättning på 5 003,6 miljarder yen (37,3 miljarder* dollar) under räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2023. Mer information finns på www.MitsubishiElectric.com

*Amerikanska dollarbelopp har omvandlats från yen med kursen ¥134=1 USD, den ungefärliga kursen på Tokyobörsen den 31 mars 2023.

* 3,3 kV/600 A Si-effektmodul (CM600DA-66X)

** 3,3 kV/750 A Full-SiC-effektmodul (FMF750DC-66A)